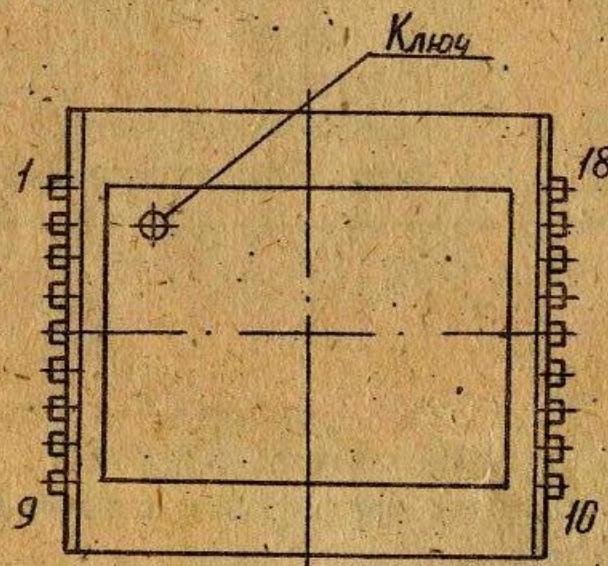


## ЭТИКЕТКА

Микросхемы типа К1602Р12 Б соответствуют ГОСТ 18725-83 и техническим условиям ОКО.348.769-02 ТУ

Микросхемы, представляющие собой запоминающие устройства на цилиндрических магнитных доменах ИС ЗУ ЦМД, предназначены для построения внешней памяти ЭВМ.

### Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.

№ вывода, полярность	Назначение вывода
I	Не задействован
2	Детектор I
3	Пассивный детектор I
4	Общий I
5	Детектор II
6	Пассивный детектор II
7	Общий II
8 (-)	Катушка "у"
9 (+)	Катушка "у"
I0 (+)	Катушка "Х"
II (-)	Катушка "Х"
I2	Не задействован
I3 (+)	Переключатель вывода-репликатор
I4 (+)	Переключатель ввода
I5 (+)	Генератор
I6 (-)	Генератор
I7 (-)	Переключатель ввода
I8 (-)	Переключатель вывода-репликатор

Масса микросхемы не более 40 г

Содержание драгметаллов в одной микросхеме

Золото 0,0090011 •

разрядов (информационных регистров) для каждой группы приведены в таблице I. Работа (запись и считывание) с дефектными регистрами не допускается.

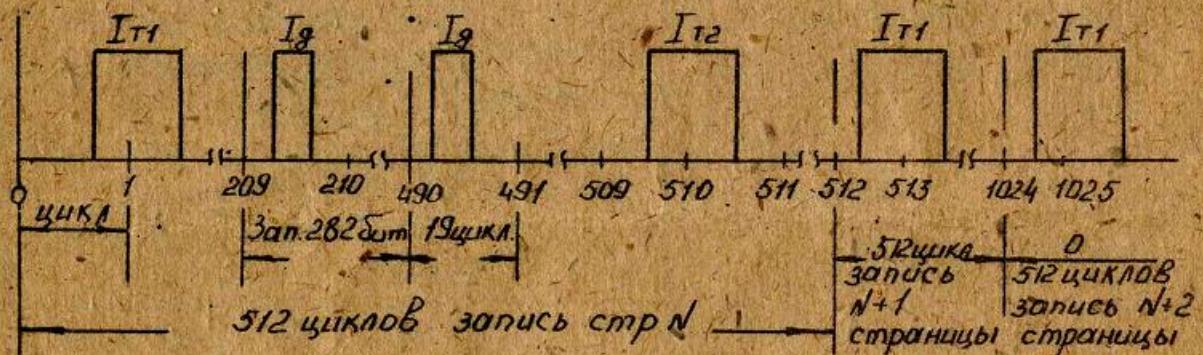


Рис. Ia. Режим непрерывной записи



Рис. Ib. Режим непрерывного неразрушающего считывания

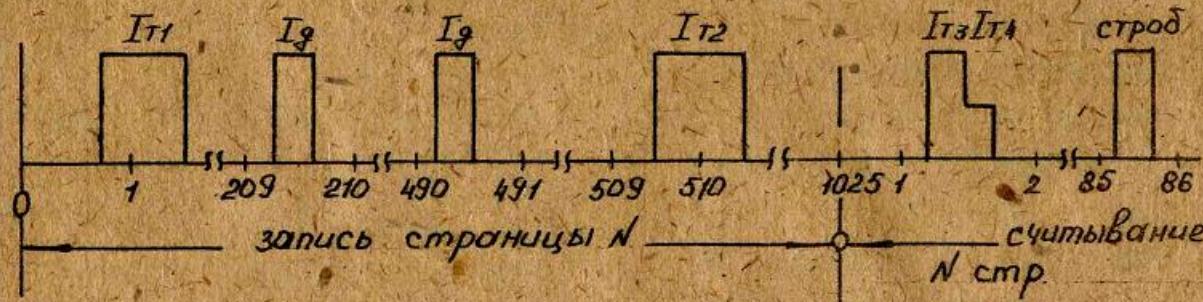


Рис. Iv. Режим записи с последующим неразрушающим считыванием той же страницы

Основные электрические параметры при  $\theta = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Таблица I

Условное обозначение микросхемы	Организация слов/х разрядность	Информационная емкость, С, бит, не менее	Амплитуда выходного сигнала логической единицы, мВ. $U_{\text{ых}}, \text{ не менее}$
K1602PЦ2A	I025 x 260	266500	2
K1602PЦ2Б	I025 x I30	133250	2

Пределые значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Таблица 2

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		на тактовой частоте функционирования $f = 100 \text{ кГц}$		предельно допустимый режим	
		не менее	не более	не менее	не более
Амплитудное значение тока в "Х" катушке, мА	$I_{Lx}$	490	590	-	900
Амплитудное значение тока в "У" катушке, мА	$I_{Ly}$	600	700	-	1000
Амплитуда импульсов тока					

Амплитудное значение тока в "Х" катушке, мА

$I_{Lx}$  490 590 - 900

Амплитудное значение тока в "У" катушке, мА

$I_{Ly}$  600 700 - 1000

Амплитуда импульсов тока

Продолжение таблицы 2

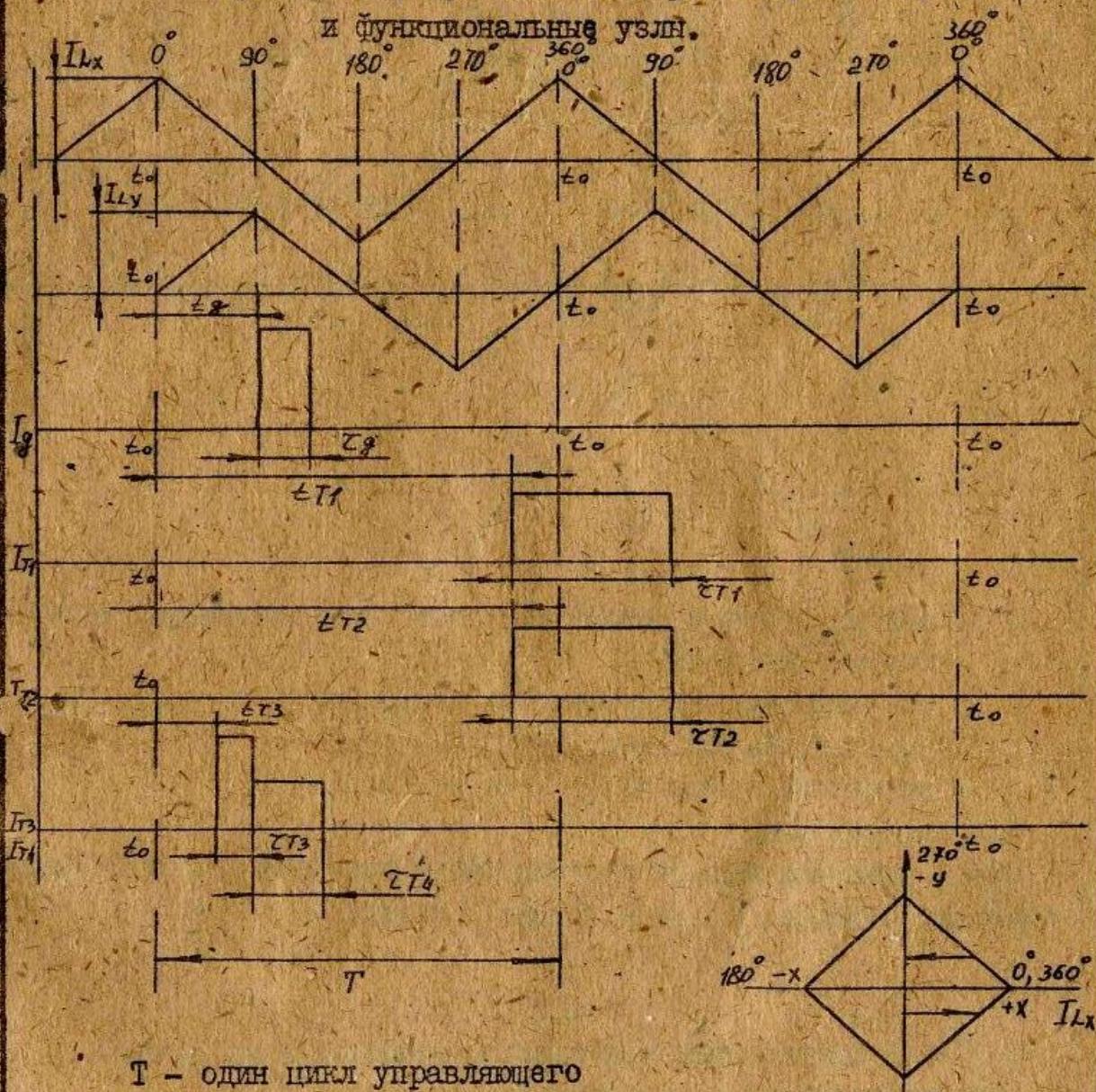
Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		на тактовой частоте функционирования $f = 100 \text{ кГц}$		предельно допустимый режим	
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
генерации, мА	$I_g$	175	225	-	300
Длительность импульса тока генерации, мкс	$\tau_g$	0,14	0,42	-	1,0
Время задержки импульса генерации, мкс	$t_g$	2,52	4,2	-	10
Амплитуда импульса тока вывода информации из регистров хранения, мА	$I_{T_1}$	30	40	-	100
Длительность импульса тока вывода информации из регистров хранения, мкс	$\tau_{T_1}$	5,6	6,72	-	10
Время задержки импульса вывода информации из регистров хранения, мкс	$t_{T_1}$	7,0	8,68	-	10
Амплитуда импульса ввода информации в регистры хранения, мА	$I_{T_2}$	30	40	-	100
Длительность импульса ввода информации в регистры хранения, мкс	$\tau_{T_2}$	5,6	6,72	-	10
Время задержки импульса					

Продолжение таблицы 2

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		на тактовой частоте функционирования $f = 100 \text{ кГц}$		предельно допустимый режим	предельный режим
		не ме- нее	не бо- лее	не ме- нее	не бо- лее
ввода информации в регистры хранения, мкс	$t_{T_2}$	7,0	8,68	-	10
Амплитуда импульса тока деления в режиме репликации, мА	$I_{T_3}$	80	120	-	200
Длительность импульса тока деления в режиме репликации, мкс	$\tau_{T_3}$	0,28	0,56	-	1,0
Время задержки импульса тока деления в режиме репликации, мкс	$t_{T_3}$	0,14	0,56	-	10
Амплитуда тока вывода в режиме репликации, мА	$I_{T_4}$	30	40	-	100
Постоянный ток детектора, мА	$I_d$	5,0	8,0	-	10
Рассеиваемая мощность, Вт	$P_{рас}$	1,0	-	1,6	
Температура хранения без потери информации, °С	$\theta$	-40	+85		
Длительность импульса тока вывода информации в режиме репликаций, мкс	$\tau_{T_4}$	2,24	3,36	-	5,0

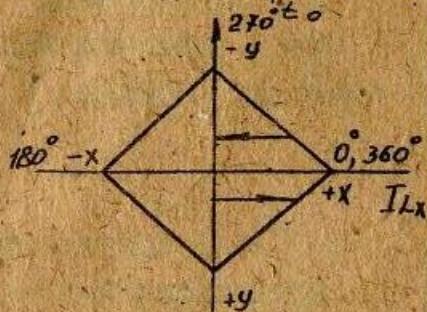
3. Формы токов, протекающих через катушки  $L_x$  и  $L_y$  и функциональные узлы микросхем, а также временные задержки импульсов управления приведены и указаны на рис. 2. Остановка поля управления в момент нахождения информации (ЦМД) в регистрах ввода, вывода или детекторах не допускается.

Форма токов, протекающих через катушки  $L_x$  и  $L_y$



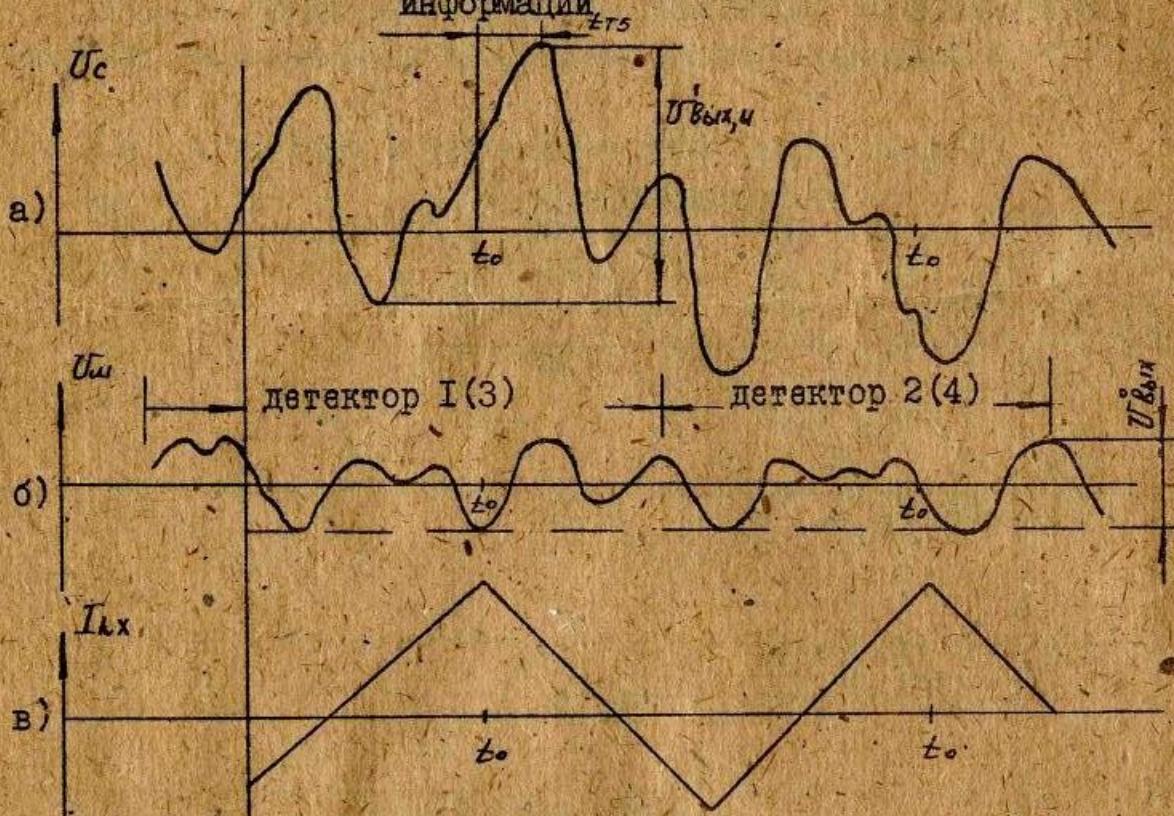
$T$  — один цикл управляющего магнитного поля.

Рис.2



4. Ориентировочная форма переходов напряжения при считывании информации приведена на рис. 3.

Форма переходов напряжения при считывании информации



а) - ориентировочная форма сигналов при прохождении домена под детекторами;

б) - ориентировочная форма шума ( $U_{\text{шум}}$ ) при отсутствии доменов под детекторами;

в) - временная привязка (ток через катушку  $L_x$ );

$t_0$  - время, мкс.

Время задержки подачи стробирующего импульса для считывания выходного сигнала ( $t_{r5}$ ) не более 3,0 мкс.

Рис.3

5. Схема организации кристалла микросхемы с указанием функциональных узлов приведена на рис. 4.

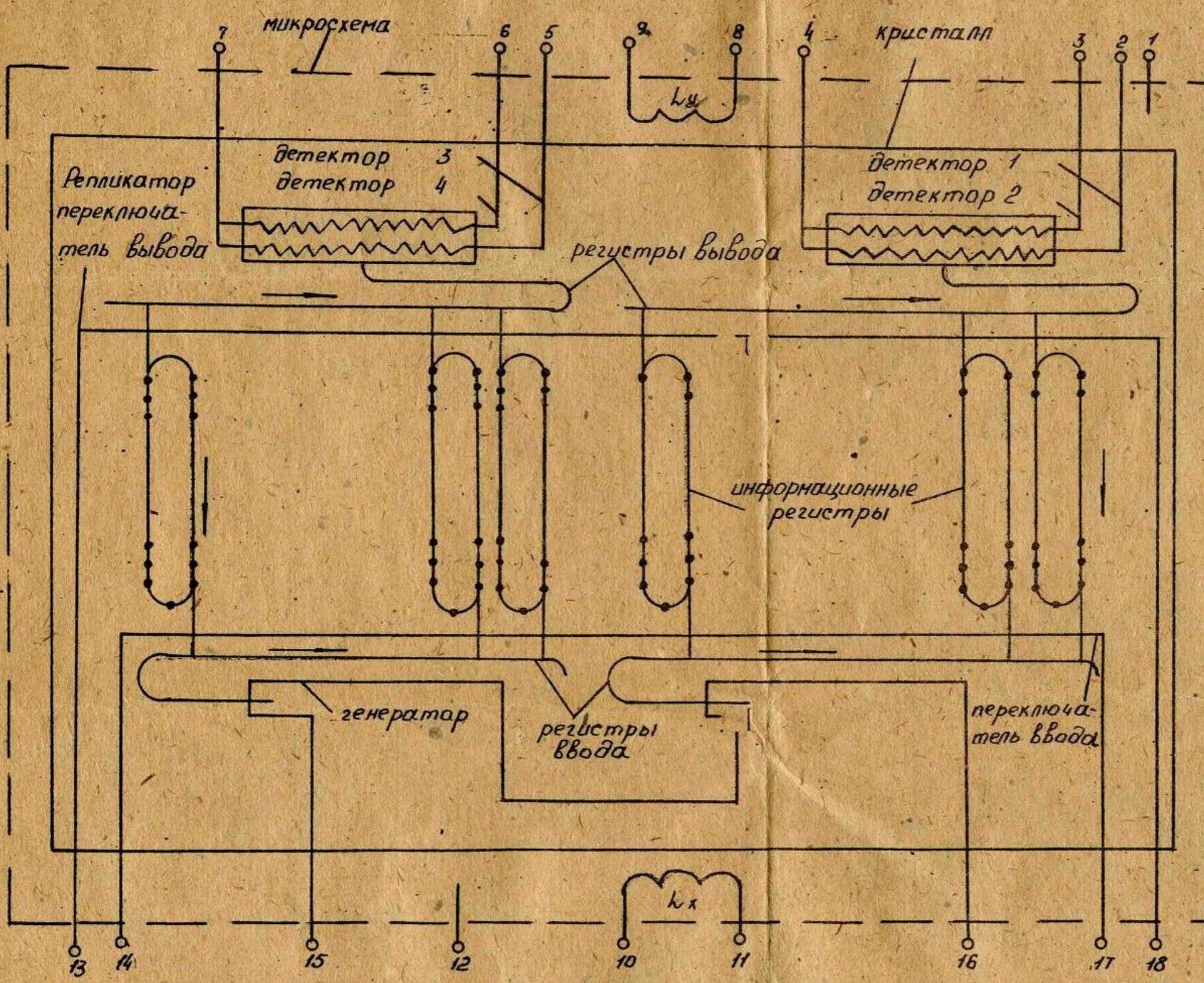
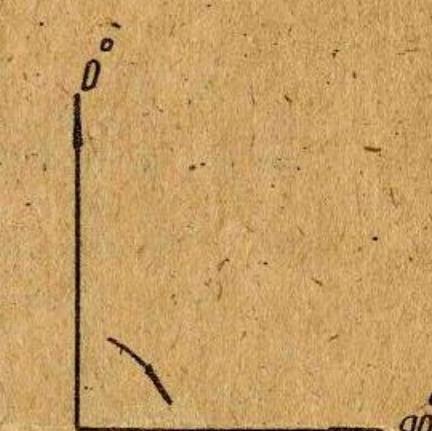


Рис.4



Зак131-2

В таблице 3 приведены значения сопротивлений функциональных элементов в диапазоне рабочих температур +I ++50°C

Таблица 3

№ п/п	Наименование функционального элемента	Сопротивление, Ом	
		Н о р м а :	
		не менее	не более
1.	Генератор	5	16
2.	Репликатор-переключатель вывода	210	650
3.	Переключатель ввода	200	550
4.	Детектор	650	1500
5.	Разность сопротивлений детекто- ров I-2		+40
6.	Разность сопротивлений детекто- ров 3-4		+40
7.	Катушка X		4,5
8.	Катушка Y		2,5

Примечание. Индуктивность катушки  $L_x$  ( 42 + 46 ) мкГн  
 Индуктивность катушки  $L_y$  ( 35 + 39 ) мкГн

6. Установку микросхем на печатную плату рекомендуется производить путем распайки выводов припоеем ПОС-61 ( ГОСТ 21931-76 ). Температура пайки не более 250°C . Продолжительность пайки каждого вывода не более 3 с.

Интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Интервал между повторными пайками не менее 5 мин.

Расстояние от корпуса до места пайки не менее 3 мм.

7. Загрязненную поверхность разрешается промывать ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом ( ГОСТ 18300-72 ).

Использование спирто-бензиновых смесей не допускается.

8. Допустимое значение статического потенциала не более 100 В.

токов управления и номера дефектных регистров приводятся на вкладыши для каждой микросхемы.

9. Использование спирто-бензиновых смесей не допускается.

ОТК-95  
05.84  
штамп ОТК.

Зак. 131-2

Микросхема № 095210

6

Амплитуды токов в катушках управления, мА	$I_{LX}$	540
	$I_{LY}$	650
Информационная емкость, бит	$C_i$	21150
Бо́льшее количество ходов		
№% дефектных регистров	—	

ОТК-95

Параметры микросхемы даны при температуре корпуса  
 $25^0 \pm 10^0\text{C}$

169

002 006 033 041 061 063 061 071 101 102 106 127 131  
142 143 145 146 164 172 206 232 237 244 245 261262  
265 271 273 275 277 302 304 307310 326 327 330 331  
333334 336 340 342 344 346 350 352 354 356360 361  
362 364 366 370 372 373374 376 400 402 404 406410  
411 412414 416417 420 422 424426 430 432